



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7576—1998  
idt IEC 747-7-4:1991  
QC 750107

---

## 半导体器件 分立器件 第7部分：双极型晶体管 第四篇 高频放大管壳额定双极型 晶体管空白详细规范

Semiconductor devices—Discrete devices  
Part 7: Bipolar transistors  
Section Four—Blank detail specification for case-rated  
bipolar transistors for high-frequency amplification

1998-11-17 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

本空白规范等同采用 1991 年发布的 IEC 747-7-4《高频放大管壳额定的双极型晶体管空白详细规范》第一版。由于该规范较原国家标准更能表征该种器件的特性,因此,对原国家标准 GB/T 7576—1987 做了修订,使之与国际标准一致。

本规范与前版的主要差别是增加了含有害物质的说明及发射极-基极反向截止电流;调整了引用总规范及分规范的标准号;删去 B9 分组高温贮存。

除非另有规定,本标准第 8 章中引用的条号对应于 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》(IEC 747-10:1991)的条号,测试方法引自 GB/T 4587—1994《半导体分立器件和集成电路 第 7 部分:双极型晶体管》(IEC 747-7:1988),试验方法引自 GB/T 4937—1995《半导体器件机械和气候试验方法》(IEC 749:1984)。

本规范由中华人民共和国电子工业部提出。

本规范由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本规范起草单位:电子工业部标准化研究所。

本规范主要起草人:蔡仁明。

## IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际间的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准,IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准由 IEC 第 47 技术委员会(半导体器件)制定。

本标准是高频放大管壳额定双极型晶体管空白详细规范。

本标准文本以下列文本为依据:

|           |            |
|-----------|------------|
| 6 个月法     | 表决报告       |
| 47(CO)984 | 47(CO)1078 |

表决批准本标准的详细资料可在上表所列的表决报告中查阅。

本标准封面上的 QC 号为国际电工委员会电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准引用的其他 IEC 标准:

IEC 68-2-17:1978 基本环境试验程序,第 2 部分:试验 试验 Q:密封

IEC 191-2:1966 半导体器件的机械标准化 第 2 部分:尺寸(在修订中)

IEC 747-1:1983 半导体器件 分立器件和集成电路 第 1 部分:总则

IEC 747-7:1988 半导体器件 分立器件和集成电路 第 7 部分:双极型晶体管

IEC 747-10:1991 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 747-11:1985 半导体器件 第 11 部分:分立器件分规范

IEC 749:1984 半导体器件 机械和气候试验方法

# 中华人民共和国国家标准

## 半导体器件 分立器件

### 第7部分:双极型晶体管

#### 第四篇 高频放大管壳额定双极型 晶体管空白详细规范

GB/T 7576—1998  
idt IEC 747-7-4:1991  
QC 750107  
代替 GB/T 7576—1987

Semiconductor devices—Discrete devices

Part 7: Bipolar transistors

Section Four—Blank detail specification for case-rated  
bipolar transistors for high-frequency amplification

#### 引言

本空白详细规范规定了制定高频放大管壳额定双极型晶体管详细规范的基本原则,制定该范围内的所有详细规范应与本空白详细规范一致。

本空白详细规范是与 GB/T 4589.1—1989《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》和 GB/T 12560—1990《半导体器件 分立器件分规范》(IEC 747-11:1985)有关的一系列空白详细规范中的一个。

#### 要求资料

下列所要求的各项内容,应列入规定的相应空栏中。

详细规范的识别:

- (1) 授权发布详细规范的国家标准机构名称。
- (2) IECQ 详细规范号。
- (3) 总规范号和分规范号以及年代号。
- (4) 详细规范号、发布日期和国家体系要求的任何更多的资料。

器件的识别:

- (5) 器件型号

(6) 典型结构和应用资料。如果设计一种器件满足若干应用,则应在详细规范中指出。这些应用的特性、极限值和检验要求均应予以满足。如果器件对静电敏感或含有害物质,例如氧化铍,则应在详细规范中附加注意事项。

- (7) 外形图和(或)引用有关的外形标准。
- (8) 质量评定类别。
- (9) 能在各器件型号之间比较的最重要特性的参考数据。

[在方括号内给出的内容供指导规范制定者使用,而不包括在详细规范内]

[整个空白详细规范中,当特性或额定值适用时,“×”表示在详细规范中应填入的值。]